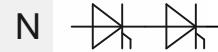


# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT 140 N 16...22**

**eupec**



## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

### Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	1600, 1800 2000, 2200	V V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DSM}$	1600, 1800 2000, 2200	V V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{RSM}$	1700, 1900 2100, 2300	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current		$I_{TRMSM}$	250	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^\circ\text{C}$ $T_C = 77^\circ\text{C}$	$I_{TAVM}$	140 159	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{TSM}$	4000 3200	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$	80000 51200	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$	150	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

### Charakteristische Werte / Characteristic values

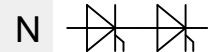
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, I_T = 500\text{A}$	$V_T$	max.	1,84	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$		0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$r_T$		1,75	mW
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$I_{GT}$	max.	150	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$V_{GT}$	max.	2,0	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$I_{GD}$	max.	10	mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_A = 5\text{W}$	$I_H$	max.	200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_{GK} \geq 10\text{W}$ $i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}, t_G = 20\mu\text{s}$	$I_L$	max.	800	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	$i_D, i_R$	max.	30	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	max.	3	$\mu\text{s}$

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT 140 N 16...22**

**eupec**



## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ , $i_{TM} = 150A$ $V_{RM} = 100V$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20V/\mu s$ , $-di_T/dt = 10A/\mu s$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O	$t_q$	typ.	300	$\mu s$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1min$ RMS, $f = 50Hz$ , $t = 1sec$	$V_{ISOL}$		2,5 3,0	kV kV

## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per module, DC pro Zweig / per arm, DC	$R_{thJC}$	max.	0,095 0,190 0,092 0,183	°C/W °C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module pro Zweig / per arm	$R_{thCK}$	max.	0,030 0,060	°C/W °C/W
Höchstzulässige Sperrsichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\ max}$		125	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		- 40...+125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		- 40...+130	°C

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact				
Innere Isolation internal insulation			A1N	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance +5% / -10%	M2	6	Nm
Gewicht weight		G	typ.	310 g
Kriechstrecke creepage distance				15 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50Hz$			50 m/s <sup>2</sup>

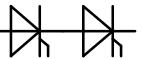
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

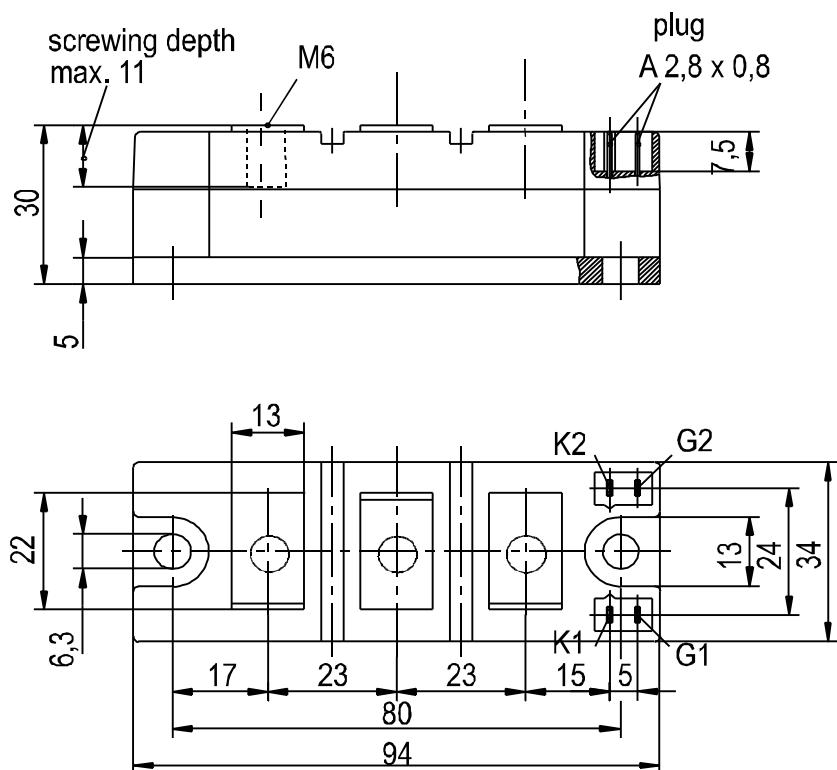
# Technische Information / Technical Information

**eup**ec

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT 140 N 16...22**

N 



# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module **TT 140 N 16...22**

**eup**ec

N 

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC

Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C} / \text{W}]$	0,0094	0,0224	0,0586	0,0924			
$\tau_n [\text{s}]$	0,0014	0,0253	0,2670	1,6800			

Analytische Funktion:  $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$